



En la posición Medición de la Resistencia o Test de Diodo respetar la polaridad por el diodo entre DRAIN (D) y SOURCE (S).  
En la posición Test de Continuidad la polaridad da igual.  
En la posición Test de Continuidad debería de oírse el zumbador cuando mida muy baja (conduce).

crea un canal de conducción y conduce entre SOURCE (S) y DRAIN (D)  
Para cargar la capacidad interna tienes cuatro métodos:  
1. (-) pila de 9 V o 6 V en GATE (G) y (+) pila de 9 V o 6 V en SOURCE (S).  
2. (-) pila de 9 V o 6 V en GATE (G) y (+) pila de 9 V o 6 V en DRAIN (D).  
3. Punta negra (-) en GATE (G) y punta roja (+) en SOURCE (S) (falla con algunos MOSFET).  
4. Punta negra (-) en GATE (G) y punta roja (+) en DRAIN (D) (falla con algunos MOSFET).

desaparece el canal de conducción y no conduce entre SOURCE (S) y DRAIN (D)  
Para descargar la capacidad interna tienes nueve métodos:  
1. (+) pila de 9 V o 6 V en GATE (G) y (-) pila de 9 V o 6 V en SOURCE (S).  
2. (+) pila de 9 V o 6 V en GATE (G) y (-) pila de 9 V o 6 V en DRAIN (D).  
3. Punta roja (+) en GATE (G) y punta negra (-) en SOURCE (S) (invertir la puntas entre GATE (G) y SOURCE (S)).  
4. Punta roja (+) en GATE (G) y punta negra (-) en DRAIN (D) (invertir la puntas entre GATE (G) y DRAIN (D)).  
5. Cortocircuitar GATE (G) y SOURCE (S).  
6. Cortocircuitar GATE (G) y DRAIN (D).  
7. Tocar con un dedo GATE (G), DRAIN (D) y SOURCE (S) a la vez (se puede averiar).  
8. Tocar con un dedo GATE (G) y DRAIN (D) a la vez (se puede averiar).  
9. Tocar con un dedo GATE (G) durante varios segundos (se puede averiar).



			MOSFET de enriquecimiento		MOSFET de empobrecimiento	
G	D	S	MOSFET de canal N	MOSFET de canal P	MOSFET de canal N	MOSFET de canal P
+	-		muy alta o sobrerango	muy alta o sobrerango	muy alta o sobrerango	NO SE FABRICAN
-	+		muy alta o sobrerango	muy alta o sobrerango	muy alta o sobrerango	
-		+	muy alta o sobrerango	muy alta o sobrerango	muy alta o sobrerango	
+		-	muy alta o sobrerango	muy alta o sobrerango	muy alta o sobrerango	
	+	-	muy baja (conduce) muy alta o sobrerango (no conduce)	muy baja (conduce) baja (lleva Diodo y no conduce)	muy baja (conduce) muy alta o sobrerango (no conduce)	
	-	+	muy baja (conduce) baja (lleva Diodo y no conduce)	muy baja (conduce) muy alta o sobrerango (no conduce)	muy baja (conduce) baja (lleva Diodo y no conduce)	

**Notas:**  
Descargarse de electricidad estática.  
No tocar las patillas con los dedos.  
Coger al transistor de la capsula o del cuerpo metálico.  
Las patillas son: izquierda (GATE), centro (DRAIN) y derecha (SOURCE).  
DRAIN es el cuerpo metálico.  
El transistor MOSFET de enriquecimiento de canal N es más usado.  
El transistor MOSFET de empobrecimiento de canal P no se fabrica.  
Para un transistor MOSFET de enriquecimiento de canal N invertir las puntas.  
El numero de medidas bajas y muy altas o sobrerango depende del orden de las medidas:  
Si conduce mide 4 muy altas o sobrerango y 2 muy bajas y si no conduce mide 5 muy altas o sobrerango y 1 baja (lleva Diodo) o mide 6 muy altas o sobrerango (no lleva Diodo).

**1º. Averiguar G:**  
Buscar 2 patillas donde mida baja o muy baja.  
La patilla que no toco es G.

**2º. Averiguar MOSFET de canal N o MOSFET de canal P:**  
Poner (+) en G y el (-) a otra patilla (da igual), mover el (+) a la patilla que no toco.  
Si mide muy baja (conduce el MOSFET) es un MOSFET de canal N o hay un Cortocircuito entre DRAIN (D) y SOURCE (S).  
Si mide muy alta o sobrerango (no conduce el MOSFET) es un MOSFET de enriquecimiento de canal P o hay un Circuito abierto entre DRAIN (D) y SOURCE (S) o Correcto (insuficiente voltaje del polímetro para crear un canal de conducción).

**3º. Averiguar D y S si lleva Diodo:**  
Canal N:  
Poner el (-) en G y el (+) a otra patilla (da igual), mover el (-) a la patilla que no toco.  
Si mide baja (conduce el Diodo) el (+) es S o Anodo del Diodo y el (-) es D o Catodo del Diodo.  
Si mide muy alta o sobrerango (no conduce el Diodo) el (-) es S o Anodo del Diodo y el (+) es D o Catodo del Diodo.  
Canal P:  
Poner el (+) en G y el (-) a otra patilla (da igual), mover el (+) a la patilla que no toco.  
Si mide baja (conduce el Diodo) el (+) es D o Anodo del Diodo y el (-) es S o Catodo del Diodo.  
Si mide muy alta o sobrerango (no conduce el Diodo) el (-) es D o Anodo del Diodo y el (+) es S o Catodo del Diodo.

**4º. Averiguar MOSFET de enriquecimiento o MOSFET de empobrecimiento:**  
Canal N:  
Cortocircuitar G y S.  
Poner el (+) en D y el (-) en S.  
Si mide muy alta o sobrerango (no conduce el MOSFET) es un MOSFET de enriquecimiento de canal N.  
Si mide muy baja (conduce el MOSFET) es un MOSFET de empobrecimiento de canal N.  
Canal P:  
Es un MOSFET de enriquecimiento de canal P porque no se fabrican MOSFET de empobrecimiento de canal P.

**Averiguar si lleva Diodo entre D y S:**  
Canal N:  
Poner el (-) en G y el (+) a otra patilla (da igual), mover el (-) a la patilla que no toco.  
Si mide baja (conduce el Diodo) lleva un Diodo entre D y S.  
Si mide muy alta o sobrerango (no conduce el Diodo), invertir las puntas entre D y S:  
Si mide baja (conduce el Diodo) lleva un Diodo entre D y S.  
Si mide muy alta o sobrerango (no conduce el Diodo) no lleva un Diodo entre D y S.  
Canal P:  
Poner el (+) en G y el (-) a otra patilla (da igual), mover el (+) a la patilla que no toco.  
Si mide baja (conduce el Diodo) lleva un Diodo entre D y S.  
Si mide muy alta o sobrerango (no conduce el Diodo), invertir las puntas entre D y S:  
Si mide baja (conduce el Diodo) lleva un Diodo entre D y S.  
Si mide muy alta o sobrerango (no conduce el Diodo) no lleva un Diodo entre D y S.